

2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2

Бескорпусные высокочастотные биполярные р-п-р транзисторы малой мощности

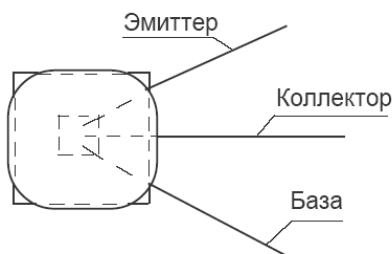
Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_T = 1,2$ ГГц
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{Kmax} = 120$ мВт
Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер $U_{Kэmax} = 35В$

Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса
2Т3150А-2 2Т3150Б-2 КТ3150Б-2	аА0.339.462 ТУ аА0.339.462 ТУ аА0.336.827 ТУ	Без корпуса, сопроводительная тара ТС4

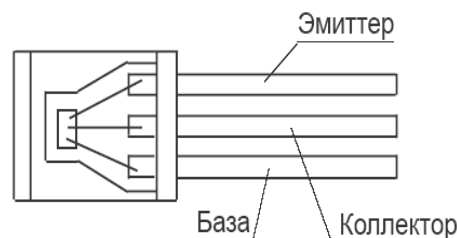
Бескорпусные на кристаллодержателе (подложке) с защитным покрытием и гибкими выводами кремниевые планарно-эпитаксиальные р-п-р усилительные транзисторы 2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2 предназначены для использования в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры.

Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям аА0.339.462 ТУ и аА0.336.827 ТУ.
Знаком Н обозначаются изделия повышенной надежности. Размеры кристалла 0,5 x 0,5 мм.

Схема расположения выводов



Сопроводительная тара



ТС4

2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2

Основные электрические параметры при температуре: 0°C ÷ + 70°C

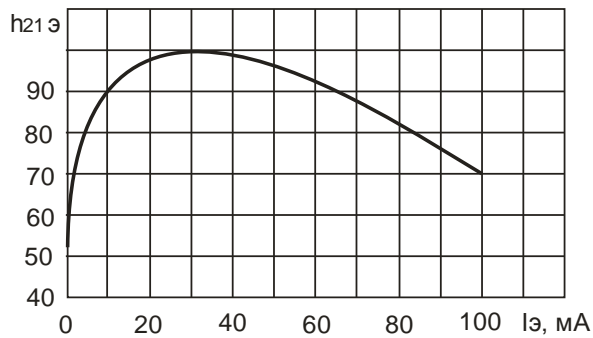
Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ}=40В$)	$I_{КБО}$		0,5
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ}=4 В$)	$I_{ЭБО}$		0,5
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ}= 5 В, I_Э= 2,5 мА, t_{и} \leq 2 мс$)	$h_{21Э}$	60	180
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ}=5 В, I_Э= 10 мА, f =100 МГц$)	$ h_{21Э} $	12	
Время рассасывания, нс ($I_К=10 мА, I_Б=1 мА$)	$t_{рас}$		30
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_К=10 мА, I_Б=1 мА$)	$U_{БЭнас}$		1,2
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_К=10 мА, I_Б=1 мА$), В	$U_{КЭнас}$		0,25
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{КБ}=5 В, I_Э=10 мА, f=30 МГц$), пс	τ_K		30
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{КБ}= 10 В, f=10МГц$)	C_K		2
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{ЭБ}= 0 В, f = 10 МГц$)	$C_Э$		2



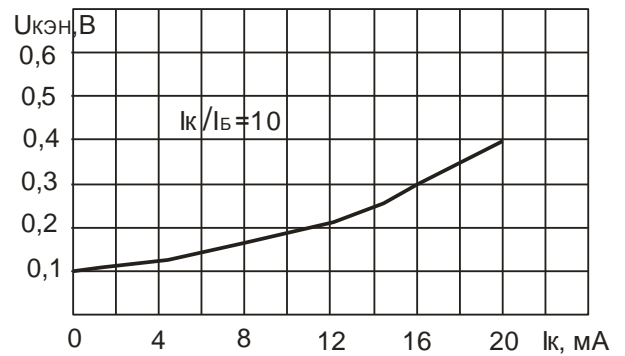
Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\max}$	40
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10 \text{ кОм}$, В	$U_{КЭ\max}$	35
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\max}$	4
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{К\max}$	30
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 2$, мА	$I_{КИ\max}$	50
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт при T до $+65^\circ\text{C}$ при $T = +85^\circ\text{C}$ При изменении температуры от $+65$ до $+85^\circ\text{C}$ $P_{К\max}$ уменьшается линейно	$P_{К\max}$	120 88
Максимальная температура р-п перехода, $^\circ\text{C}$	$T_{П\max}$	125
Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Тп-с}$	450

Основные типовые зависимости параметров транзисторов



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.